

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	(3)
Abstract	(5)
กิตติกรรมประกาศ	(6)
สารบัญ	(7)
รายการตาราง	(9)
รายการภาพประกอบ	(10)
ตัวย่อและสัญลักษณ์	(14)
บทที่	
1 บทนำ	1
บทนำต้นเรื่อง	1
การตรวจเอกสาร	3
วัตถุประสงค์	8
2 ทฤษฎี	9
ประวัติการพบปรากฏการณ์ไพโซอิเล็กทริก	9
เซรามิกเลดเซอร์โคเนทไทเทเนท	11
กระบวนการอบพ่น	16
กระบวนการโพลิง	18
สมบัติไพโซอิเล็กทริก	19
การปรับปรุงสมบัติ PZT	31
จุลโครงสร้างกับสมบัติไพโซอิเล็กทริก	33
3 วัสดุและวิธีการวิจัย	35
วัสดุ	35
อุปกรณ์	36
วิธีดำเนินการ	37
การตรวจสอบสมบัติทางกายภาพ	40
การตรวจสอบสมบัติทางไฟฟ้า	43
การทำให้เป็นชิ้นงาน	45
4 ผลและการอภิปรายผล	46

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
การตรวจสอบสมบัติทางกายภาพ PZT	46
การตรวจสอบสมบัติทางไฟฟ้า PZT	53
การทำเป็นชิ้นงาน	65
5 บทสรุป	67
สรุปการทดลอง	67
ข้อเสนอแนะ	68
งานวิจัยในอนาคต	69
บรรณานุกรม	70
ภาคผนวก	74
ภาคผนวก (ก)	74
ภาคผนวก (ข)	78
ภาคผนวก (ค)	83
ประวัติผู้เขียน	84

รายการตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 แสดงความสัมพันธ์ของค่าคงที่ไพเอโซอิเล็กทริกกับตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	21
2.2 แสดงลักษณะรูปทรงและทิศทางการยึดหดของวัสดุไพเอโซอิเล็กทริก	26
5.1 แสดงค่าสมบัติทางกายภาพของ $\text{Pb}(\text{Zr}_{0.52}\text{Ti}_{0.48})\text{O}_3$	67
5.2 แสดงค่าสมบัติทางไฟฟ้าของ $\text{Pb}(\text{Zr}_{0.52}\text{Ti}_{0.48})\text{O}_3$	67

รายการภาพประกอบ

ภาพประกอบที่	หน้า
1.1 แสดงการเกิดปรากฏการณ์ไพโซอิเล็กทริกแบบตรงและแบบผกผัน	1
2.1 แสดงการจัดกลุ่มผลึกตามความสมมาตรของผลึก	10
2.2 แสดงค่าคงที่ไดอิเล็กทริกและค่ากับจำนวนเปอร์เซ็นต์โมลระหว่าง $PbTiO_3$ กับ $PbZrO_3$ ที่อุณหภูมิ $25\text{ }^{\circ}C$	11
2.3 แสดงค่าคงที่ไพโซอิเล็กทริกและค่าพลาเนาร์คัปปลิงแฟกเตอร์กับจำนวนเปอร์เซ็นต์โมลระหว่าง $PbTiO_3$ กับ $PbZrO_3$ ที่อุณหภูมิ $25\text{ }^{\circ}C$	12
2.4 แสดงเฟสโครงสร้างผลึก PZT	13
2.5 ค่าความยาวโครงผลึกของ $PbTiO_3 - PbZrO_3$ ที่อุณหภูมิ $25\text{ }^{\circ}C$	14
2.6 แสดงโครงสร้างผลึกแบบเพอโรฟสไกต์	14
2.7 แสดงลักษณะเฟสของ $PbTiO_3 - PbZrO_3$ ที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่อุณหภูมิคูรีและบริเวณ MPB	15
2.8 (a) แสดง 6 ทิศทางสำหรับการโพลาริเซชันในโครงผลึกแบบเตตระโกนอล (b) แสดง 8 ทิศทางสำหรับการโพลาริเซชันในโครงผลึกแบบรอมโบฮีดรัล	16
2.9 แสดงการเกิดคอค	17
2.10 แสดงกระบวนการอบผนึก	17
2.11 แสดงการจัดเรียงตัวของการโพลาริเซชันก่อนและหลังได้รับสนามไฟฟ้า	18
2.12 แสดงเครื่องหมายของแกนสำหรับวัสดุไพโซเซรามิก	20
2.13 แสดงลักษณะวงจรมูลใน PZT ในกรณีไม่เกิดการเรโซแนนซ์ (a) กรณีขนาน และ (b) กรณีอนุกรม	23
2.14 วงจรมูลของเมสัน	23
2.15 แสดงลักษณะค่าความถี่เรโซแนนซ์และค่าความถี่แอนติเรโซแนนซ์	24
2.16 แสดงค่า k_p เมื่อเติมสารเจือคือ Nb_2O_5 ใน PZT	32
2.17 แสดงค่า k_p เมื่อเติมสารเจือคือ Na_2O ใน PZT	32
2.18 ลักษณะจุดโครงสร้างของ PZT เมื่ออบผนึก $1100\text{ }^{\circ}C$ 1 ชั่วโมง (a) บดผสม 20 ชั่วโมง (b) บดผสม 40 ชั่วโมง (c) บดผสม 60 ชั่วโมง และ (d) บดผสม 80 ชั่วโมง	33
2.19 แสดงลักษณะผลของอุณหภูมิตอบผนึกกับความหนาแน่น ขนาดเกรนเฉลี่ยกับ อุณหภูมิและค่าคัปปลิงแฟกเตอร์กับขนาดเกรนเฉลี่ย	34

รายการภาพประกอบ (ต่อ)

ภาพประกอบที่	หน้า
3.1 แสดงลักษณะเตาเผา	38
3.2 แสดงช่วงเวลาและอัตราอุณหภูมิของการเผาแคลไซน์	38
3.3 แสดงลักษณะแม่พิมพ์	39
3.4 แสดงการวางสารตัวอย่างในถ้วยเผาซึ่งหมายเลข 1 คือถ้วยอะลูมินา หมายเลข 2 คือสารตัวอย่าง หมายเลข 3 คือ ผง $PbZrO_3$ ซึ่งกลบคลุมสารตัวอย่างหมายเลข 4 คือผงอะลูมินาใช้ผง $PbZrO_3$ กลบคลุมอีกครั้ง	39
3.5 แสดงช่วงเวลาและอัตราอุณหภูมิของการอบผืนึก	40
3.6 แสดงลักษณะการซิงเซรามิกขณะอยู่ในน้ำ 1 เครื่องซิง 2 โต้ะ 3 บีกเกอร์ 4 สารตัวอย่าง PZT 5 น้ำกลั่น	41
3.7 ลักษณะการ โพลิง ① ไมโคร โปรเซเซอร์ เทอร์โมมิเตอร์ ② แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ③ เตาน้ำคำ ④ บีกเกอร์ ⑤ เทอร์โมคอบเปิล ⑥ ขาดัง ⑦ สารตัวอย่าง	43
3.8 แสดงลักษณะชุดทดลองเกี่ยวกับการวัดค่าไดอิเล็กทริกเทียบอุณหภูมิ	44
3.9 วงจรวัดค่าความถี่เรโซแนนซ์และแอนติเรโซแนนซ์ เมื่อความต่างศักย์คงที่	44
3.10 แสดงลักษณะชิ้นงานที่มี PZT เป็นส่วนประกอบ 1 คือแท่นรองแผ่นทองเหลือง 2 คือสารตัวอย่าง PZT 3 คือ สายไฟ	45
4.1 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรกับขนาดอนุภาค	46
4.2 แสดงลวดลายการเลี้ยวเบนของผง PZT เมื่ออบผืนึกที่ $1200\text{ }^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง	47
4.3 แสดงลวดลายการเลี้ยวเบน ของผง PZT เมื่ออบผืนึกที่ $1250\text{ }^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง	48
4.4 แสดงลวดลายการเลี้ยวเบนของผง PZT เมื่ออบผืนึกที่ $1285\text{ }^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง	48
4.5 แสดงลักษณะเกรน ของ PZT ที่อบผืนึกที่ $1200\text{ }^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง	49
4.6 แสดงลักษณะเกรน ของ PZT ที่อบผืนึกที่ $1250\text{ }^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง	49
4.7 แสดงลักษณะเกรน ของ PZT ที่อบผืนึกที่ $1285\text{ }^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง	50
4.8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดเกรนกับอุณหภูมิอบผืนึก	50
4.9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกับอุณหภูมิอบผืนึก	51
4.10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำกับอุณหภูมิอบผืนึก	52
4.11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเปอร์เซ็นต์ความพรุนกับอุณหภูมิอบผืนึก	52
4.12 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่ไดอิเล็กทริกกับอุณหภูมิอบผืนึก	53

รายการภาพประกอบ (ต่อ)

ภาพประกอบที่	หน้า
4.13 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริกกับอุณหภูมิอบผืนึก	54
4.14 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่ไดอิเล็กทริกกับขนาดเกรน	54
4.15 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่ไดอิเล็กทริกกับความถี่	55
4.16 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริกกับความถี่	55
4.17 แสดงลักษณะการจذبวงสสารตัวอย่างภายในเตาควบคุมอุณหภูมิ	56
4.18 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่ไดอิเล็กทริกกับอุณหภูมิของ PZT ที่ผ่านการอบผืนึกที่ $1200\text{ }^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง มีอุณหภูมิคูรี $380\text{ }^{\circ}\text{C}$	57
4.19 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่ไดอิเล็กทริกกับอุณหภูมิของ PZT ที่ผ่านการอบผืนึกที่ $1250\text{ }^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง มีอุณหภูมิคูรี $385\text{ }^{\circ}\text{C}$	57
4.20 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่ไดอิเล็กทริกกับอุณหภูมิของ PZT ที่ผ่านการอบผืนึกที่ $1285\text{ }^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง มีอุณหภูมิคูรี $385\text{ }^{\circ}\text{C}$	58
4.21 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความถี่กับค่าความต่างศักย์สำหรับ PKI 402 มีค่าความถี่เรโซแนนซ์และแอนติเรโซแนนซ์เท่ากับ 186 และ 194 kHz ตามลำดับ	59
4.22 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความถี่กับค่าความต่างศักย์สำหรับ PZT ที่อบผืนึกที่ $1200\text{ }^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง มีค่าความถี่เรโซแนนซ์และแอนติเรโซแนนซ์เท่ากับ 173 และ 175 kHz ตามลำดับ	60
4.23 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความถี่กับค่าความต่างศักย์สำหรับ PZT ที่อบผืนึกที่ $1250\text{ }^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง มีค่าความถี่เรโซแนนซ์และแอนติเรโซแนนซ์เท่ากับ 191 และ 194 kHz ตามลำดับ	60
4.24 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความถี่กับค่าความต่างศักย์สำหรับ PZT ที่อบผืนึกที่ $1285\text{ }^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง มีค่าความถี่เรโซแนนซ์และแอนติเรโซแนนซ์เท่ากับ 193 และ 196 kHz ตามลำดับ	61
4.25 แสดงความสัมพันธ์ของค่าพลานาร์คัปปลิงแฟกเตอร์กับอุณหภูมิอบผืนึก	61
4.26 แสดงความสัมพันธ์ของค่าคัปปลิงแฟกเตอร์ k_{31} กับอุณหภูมิอบผืนึก	62
4.27 แสดงความสัมพันธ์ของค่าคงที่ไพโซโซอิเล็กทริก d_{31} กับอุณหภูมิอบผืนึก	62
4.28 แสดงความสัมพันธ์ของค่าคงที่ไพโซโซอิเล็กทริก g_{31} กับอุณหภูมิอบผืนึก	63

รายการภาพประกอบ (ต่อ)

ภาพประกอบที่	หน้า
4.29 แสดงความสัมพันธ์ของค่าคงที่ยืดหยุ่น s_{11}^E กับอุณหภูมิอบผืนึกต่างๆ	63
4.30 แสดงความสัมพันธ์ของค่าความเร็วเสียงใน PZT กับอุณหภูมิอบผืนึกต่างๆ	64
4.31 ตัวกำเนิดเสียงซึ่งมี PZT เป็นส่วนประกอบหลัก	65
4.32 แสดงลักษณะการตรวจสอบการตอบสนองต่อสัญญาณไฟฟ้า	65

ตัวย่อและสัญลักษณ์

A	=	พื้นที่ หรือพื้นที่ขั้วไฟฟ้า
A_b	=	เปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำ
c	=	ค่าคงที่ความแข็ง
C	=	ความจุไฟฟ้า
D	=	การกระจัดทางไฟฟ้า
d, e	=	ค่าคงที่ไพเอโซอิเล็กทริกความเครียด
E	=	สนามไฟฟ้า
f_a	=	ความถี่แอนติเรโซแนนซ์
f_r	=	ความถี่เรโซแนนซ์
g, h	=	ค่าคงที่ไพเอโซอิเล็กทริกความเค้น
k	=	ค่าคัปปลิงแพกเตอร์
k_p	=	ค่าพลาเนอรีคัปปลิงแพกเตอร์
k_t	=	ค่าคัปปลิงแพกเตอร์ในแนวความหนา
k_{31}	=	ค่าคัปปลิงแพกเตอร์ในแนวความยาว
k_{33}	=	ค่าคัปปลิงแพกเตอร์ในแนวความยาว
k_{15}	=	ค่าคัปปลิงแพกเตอร์ในแนวเฉือน
L	=	ความหนา ความยาว
l	=	ความยาว
P	=	ความดัน หรือแรงดันต่อพื้นที่
P_p	=	เปอร์เซ็นต์ความพรุน
Q_m	=	แพกเตอร์คุณภาพ
R	=	ความต้านทานไฟฟ้า
r	=	รัศมี
S	=	ความเครียดกล
s^E	=	ค่าคงที่ยืดหยุ่นภายใต้สนามไฟฟ้าคงที่
T	=	ความเค้นกล
t	=	ความหนา

ตัวย่อและสัญลักษณ์ (ต่อ)

J_0	=	เบสเซลฟังก์ชันอันดับที่ศูนย์
J_1	=	เบสเซลฟังก์ชันอันดับที่หนึ่ง
η	=	ค่าบวกของรากที่ต่ำที่สุดของ $(1 + \sigma^E) J_1(\eta) = \eta J_0(\eta)$
σ^E	=	อัตราส่วนของปีวส์ของ
ρ_b	=	ความหนาแน่น
ρ_w	=	ความหนาแน่นของน้ำกลั่นที่อุณหภูมิขณะทดลอง
ε	=	สภาพยอมได้ทางไฟฟ้าของวัสดุ
ε_r	=	ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก
ε^T	=	สภาพยอมได้ทางไฟฟ้าภายใต้ความเค้นคงที่
v	=	ค่าความเร็วเสียงในวัสดุ
W_d	=	น้ำหนักของสารตัวอย่างหลังอบแห้ง
W_a	=	น้ำหนักของสารตัวอย่างขณะชั่งน้ำชั่งในอากาศ
W_{aw}	=	น้ำหนักในน้ำของสารตัวอย่าง
ω	=	ความเร็วเชิงมุม
Z	=	ความต้านทานเชิงซ้อน
Z_m	=	ความต้านทานเชิงซ้อนที่ความถี่เรโซแนนซ์